

特 許 願(Z.

昭和48年 //月 3/日

特許庁長官 斉 華 英 雄 殿

1. 発明の名称

が オードリング タング アングラング 単化 ゴム系ラオト レジスト 組成権

.2.劳 明 者

ララシャン サカスは877年 エ 興山県倉敷市福津東青江 2 0.4 7 の1 サマーダーター データー 田 展 英 章

(ほか3名)

3. 特許出願人

倉敷市酒津1621番地

(108) 株式会社 ク ラ

4. 代 理 人

大阪市北区梅田 8 番坤 新阪急ビル 株式会社 ク ラ レ 内 電話大阪 06 (346) 1351 (代表)

3747) 弁 里 士 本 多 (東京連絡先)

(東京連絡ル) 株式会社 クラレ 東京支社支社長付 電 點 東 京 03 (272) 0311 (代表)



16

- 単質の名誉

着化ゴム英フォトレジスト組成物

2. 特許請求の報題

マレイン化もしくはエポキシ化した孵化ゴムと タアダド茶光架器所とからなる環化ゴム系フォト レビスト紙底物。

3. 是明の詳細を説明

本売明は、フォトレジスト組成物が整布される 基材に対して改良された密着性を有する現化ゴム - ジアジドネフォトレジスト組成物に関する。

写真技術により、特定な部分に活性溶剤に耐える保護皮膜を形成し、それ以外の部分を活性溶剤により溶解除金するフォトエッチングの技術は、近年精密加工法として超々の技術分野で利用されている。特にエレクトロニケスの分野では広く取り入れられ、ブリント図鏡、オワーテンピのシャドーマスケの製作、トランジスタ、集積回路(IO)をどの製造に使用されている。たかでもトランジスタとI の の製造にかいてフォトエッチング技術

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-72702

④公開日 昭50.(1975) 6.16

②特願昭 48-123027

②出願日 昭48.(1973)/0.3/

審査請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号 6023 58 7265 46 6650 57

6906 46

⑩日本分類 116 A415

103 B1 250)B2 59 G4 61 Int. C12

G03C 1/70 B4ID 7/00

C08C 19/00 H05K 1/00

CO9K 13/00

. 水台に世事視されている。

エフテング技術にかいて、業績に耐える (フォトレジスト)に要求される点とし ては、基材に強固に付着し、均一で、ピンホール がたく、耐食性が強いことである。従来、フォト レジストとして、ポリ桂皮酸ピニル系、着化ゴム ージアジド某なよびキノンアジド系などが知られ ているが、現在IC製造用として主として使用さ れているのは、上述の性能を比較的満たしている 養化ゴムージアジド系のものである。IOを製造 する際にフォトレジストは、基材たとえばシリコ ンの表面を散化して得られた散化シリコン(810g) の活性溶剤に対する保護皮膜として用いられる。 現在一般に使用されているフォトレジストでは、 マスタを施された基材を活性溶剤でエフテングす る際に、第1回に示したように、フォトレジスト 皮膜が基材要要からめくれ易いことが模姿されて

とのことは、レジスト皮膜と基材との結合力が、 活性溶剤と基材との結合力より調い時に起こる。

特別 昭50-72702(2)

のと考えられ、アンダーカットの原因となつてい る。アンダーカットが起これば、必要な部分まで 活性溶剤により除去され、不合格製品となる。と のため、ある程度のアンダーカットを見込んでパ ターンを作つているのが現状である。しかしたが、 ちェレクトロニクス技術の急速を発展にとるない、 1 Cはますます集務度を上げ、LSIPMOS型・ ICの開発が進み、より高性能のフォトレジスト が望まれており、特に前述のアンダーカット巾の 可能を限り小さいものが求められている。IC用 フォトレジストの基材である酸化シリコン(8102) の表面は、微量の水分と反応してシッノール(SiOH) のようにをつているといわれている。そのため無 極性の環化ゴムをレジストとして用いた場合には、 個性基である 0 日との相互作用がほとんどたく、 環化ゴムの分子量、二重結合量、分子量分布等を 変えても、現在の環化ゴムより酸化シリコンへの 密着性が大きく改良される可能性は少ないと考え られる。現在までに、镰化ゴム来フォドレジスト の基材、例えば酸化シリコン等に対する密着性の

ル酸メチル、メタアクリル酸メチル等との共産合体に、塩化鉄、塩化アルミニウム、四塩化ポン、三臭化ピスマス、五塩化アンチモ、砂塩化研索、三塩化研索、五塩化焼等の気体、砂体の環化剤を作用させることによっては、水の調製に使用する環化ゴムをしては、フォトレンスト用に通常使用されていたとしては、フォトレンスト用に通常使用されていたとしてなるのが好きしいが、一般にトルエン中30℃にかける仮としてが、一般にトルエン中30℃にかける仮としているの環化ゴムが使用可能である。

本発明において使用されるマレイン化した環化 ゴムは、①環化ゴムを無水マレイン酸と反応させ て得られる環化ゴムー無水マレイン酸付加物、② とうして環化ゴムに導入された無水マレイン酸を、 必要に応じてロートルエンスルホン酸のような触 蝶の存在下、メタノール、エタノール、ローブタ ノール等のアルコール、またはアンモニア、ロー プロビルアミン等のアミン類と加熱反応させて、 世界方法としては、基材の表面に密着性重良のための物質を整布したのち、フォトレジストを動布する方法や、ブオトレジスト中に密着性改良のための物質を添加する方法が提案されている。 しかしたがら、前者の方法では作業の工程が増える。 しいっケ点があり、また添加や幾布する物質が高値であつたり、有寒であつたりして、必ずしも充分満足すべきものではない。

本発明は、上期間題を解決し、基材とくに変面がシラノール状の酸化シリコンに対する密着性を改善した環化ゴム系フォトレジストを明らかにするものである。すなわち本発明によれば、マレイン化もしくはエポキシ化した環化ゴムとジアジド系光架緩削とからなる、基材に対する密着性の改善された環化ゴム系フォトレジスト組成物が提供される。

環化コムは、公知のように、天然ゴム、ジェン 系合成ゴム例をばポリイソプレン、ポリプタジェン、共役ジェンと他の不飽和単量体例をばスチレン、メチルスチレン、アクリロニトリル、アクリ

素、あるいは芳香族炭化水素とローへキサン、ローヘブダン等の飽和脂肪族炭化水素との混合物を溶媒として、ラジカル発生触媒の存在下、温度
4 0~100 Cで溶液状で反応を行なりのが特に好ましい。ラジカル発生触媒としては、ビニル化合物の番常のラジカル重合に使用されているものを

思いるととができる。

本発明にかいて、上記受性選化ゴム中の無水マレイン酸またはその誘導体の付加量は、選化ゴム100 f あたり 5×10 ~ 4×10 = モルが適当であり、またエボキシ基(0-0) の含量は、酸ゴム108 f あたり 5×10 = ペ8×18 = モルが適当である。数要性環化ゴムは、それ単独で使用してもよ

レイソプレン発展登録前標クラブレンIR-10)
10.0 9をキャレン1909に海豚し、P-トルエンスルホン酸 1.0 9を加えて、90~1000で変変 重要器を中1時間提择した。室温をで冷却したのち炭酸コルシウムを加えて反応を停止させた。反応液を進心分離機にかけ、上澄み液を多量のアセトン中に注ぎ、生成した沈殿を減圧下、室温で乾燥した。毎られた環化ゴム()は不飽和度44%、振眼粘度〔1〕(トルエン中30°C)0.70(d/f)であつた。

(2) 華化ゴムー無水マレイン酸付加糖の製造

前記(1)で得られた選化ゴム(I) 2・0 すをキシレン4 8 年に溶解したのち、無水マレイン酸 0・2 手を 最加し、さらにアゾピスイソプチロニトリル 0・804 サを加え、窒素雰囲気中 9 0 でで 5 時間反応した。 反応混合物をアセトン中に投入し、沈酸を評別して減圧下塩温で乾燥した。反応生成物をペンゼンに溶解し、エチノールーベンゼン混合溶剤(1 : 4 容量比)の水酸化ナトリウム溶液を用いて、フェノールフォレインを排示薬として消定し、無水 く、変性していたい輩化ゴムと場合して使用して もよい。

本発明のフォトレジスト組成物の製造におたり、 光架響剤としてのジアジドは、一般に悪化ゴムー ジアジド系フォトレジストの光架響剤として使用 されているアリールビスジアジドが、通常の使用 量の範囲で用いられる。典型的なものとしては 4.41ージアジドステルベン、2.6 ーピス(4 ーア ジドベンジリデン)ー4 ーメテルシクロヘキサノ ン、Pーフェニレンーピスアジド等である。

本発明のフォトレジストは、単に基材に対する 密着性が著しく向上しているばかりでなく、感光 度、耐腐蝕剤性にも優れてかり、その優れた樹着 性、耐腐蝕剤性、感光度のために、特に半導体IC の製造の際の歩留りの向上、集積密度の病上に大 きく寄与するものである。

以下に実施例により本発明を具体的に説明する。

(1) 環化ゴム(1) の製造

楽練 りしたシスー 1・4 ーポリイソ ブレン(タワ

マレイン酸の付加量を測定した。無水マレイン酸の付加量は環化ゴム100 f あたり 6×10 m モルであつた。

(3) 選化ゴムーマレインイミド付加物の製造

(1) で得られた環化ゴム(1) 2.0 fをキシレン4 8 f に海解したのちマレインイミド 0.2 f を添加し、さらにアゾビスイソプチロニトリル 0.004 fを加え、企業雰囲気中 9 0 G で 5 時間反応した。反応混合物を多量のメタノール中に投入して沈殿を河兜し、減圧下室温で乾燥した。

(4) 環化ゴム側の製造

来頼りしたシスー1,4~ボリイソプレン(クラレイソプレン倫製クラプレンIR-10)10.0 まをキシレン190まに溶解したのちP-トルエンスルホン酸 0.5 まを加え、猛素雰囲気中100 0で5時間視性した。宝温主で冷却したのち炭酸カルンウムを加えて反応を停止した。反応液を適心分離機にかけ、上澄み液を多量のアセトン中に注ぎ、生成沈艰を評別し、減圧下室温で乾燥した。得られた硬化ゴム(身は不動和度 45%、還元粘度(約1417/3) もつた.

(5) エポキシ化理化ゴムの製造

はで移られた著化ゴム(1.5 まをペンゼン100 OK に溶解し、ヨークロル過安息音像 D . 2.5 . f を加 えて宣揚で1時間提择した。次いで多量のアセト ン中に注いで沈殿を評別し、減圧下宙艦で戦慄し

首節(1)~(5)で得られた環化ゴム(1)、係やよび変 性番化ゴムをそれぞれキシレンに溶解し、光葆馨 潮として 2,6 ーピス(4-アジドベンジリデン) ーイーメチルシグロヘキサノンを導化ゴギに対し てる重量が加えてフォトレジスト溶液とし、スラ イドガラスにスピンナーで他布し、乾燥して厚さ 0.4 #の被膜とした。90℃で15分間アンベー キングし、ネガマスクを乗して250ワツト超高圧 水根灯(カシオ電気製)にて所定時間電光した。 でで20分間ポストペーキングした。

得られたレジスト被膜を 0.5 ガフツ化水素酸

て行きつた。要先職後諸用ステイドガラス(マッ ナシガラス社製)に、フォトレジスト準度を告省 し、 厚さ 8.6 μの皮膜とした。 前途のようにして パターンを作成し、0.5 ボファ化水素酸(フッ化 アンモニウムを含む)中に宣議で50分間長渡し てエフチングを行なつた。エツチング首後のパメ ーンを顕微鏡で観察してアンダーカット市を測定 した。

4. 郷育の簡単を説明

第1回は、エフチングに楽し、フォトレジスト 皮膜が基材に強固に付着している皮好を伏線を示 し、第2回は数皮膜が基材表面がらめくれている

特朗 昭50-72702 (4)

(ファ化アンモニウムを含む)中に宜温にてるの 分間浸漉を行なつたところ、レジスト被機の耐腐 魚剤性は、前記(2)、(5) ☆よび(5)で得られた変性着 化ゴムを使用した場合と、(1) かよび(4) で得られた 米変性類化ゴムを使用した場合とも遅れてかり、 両者にはほとんど差がみられなかつた。アンダー カット巾について測定した結果を表しに示す。

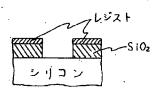
•	-	_	•	-	- 2	,,	7 7 7	
 		,						
1		١.,		1.		- 1		- 1
1 (7)	1 (:	2)	1	(3)		(4)	- 1

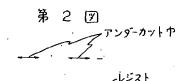
以	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IN 19	(米処理)	(3N(3/E)	マレイミドル()	(未処理)	(marset)
アンダーカット	6 1	4.7			
市 (*)		• ′	4 8	6.3	4 9

前記(1) および(4) で得られた未変性の最化ゴムを ペースポリマーとした場合と比較すると、は、は かよび(5) で得られた変性器化ゴムをペースポリマ ~として使用した場合には、鉱材に対する密着性 が著しく内上しているととがわかる。

たち、アンダーカット巾の瀬定は次のようにし









5. 添付書類の目録

(1) 副 本 1 通 (2) 明 細 書 1 通 (3) 委 任 状 1 通

6.前配以外の発明者

* ヤ がり (イ *** 大阪府寝屋川市三井が丘 1 の 8 イ メ (*** /18 和 泉 正 劇

<Publication No. JP-A No.50-72702> Title "Cyclized Rubber Photoresist Composition"

Page 2 right upper column line 17 to page 3 right upper column line 2

As generally known, cyclized rubbers can be obtained by applying a cyclizing agent of a gas, liquid, or a solid substance such as ferric chloride, aluminum chloride, tetrachloride tin, tribromide. tetrachloride titanium, bismuth antimony pentachloride, boron trifluoride, boron trichloride, and phosphoric chloride to a copolymer of: a natural rubber or a diene synthesized rubber such as polyisoprene, polybutadiene or a conjugatediene , and another unsaturated monomer such as styrene, methylstyrene, acrylonitrile, methyl acrylate and methyl methacrylate. As a cyclized rubber used for the preparation of the malleine reacted or epoxidized cyclized rubber of the present invention, it is preferable to use one generally used for photoresist. In general, a cyclized rubber having a limiting viscosity (η) of 0.1 to 2.0 (dl/g) and an unsaturation degree of 20 to 70 % in toluene at 30 $^{\circ}\mathrm{C}$ can be used.

The mullein reacted cyclized rubber used in the present invention includes the followings: (1) an adduct of cyclized rubber-maleic anhydride obtained by reacting a cyclized rubber with maleic anhydride; (2) a substance obtained by heating and reacting the maleic anhydride thereby introduced into the cyclized rubber with an alcohol such as methanol, ethanol or n-butanol, or with ammonia, or amines such as n-propylamine, under the presence of a catalyst such as n-toluenesulfon if needed, and by amidating/imidating/making one side or both sides of a carboxyl group based on the maleic anhydride into a structure of an ester corresponding thereto; (3) a substance in which an acid anhydride group of the maleic anhydride introduced into the cyclized rubber is hydrolyzed and made into a free carboxyl group or a metal group thereof; and (4) a

substance obtained by reacting the cyclized rubber with maleic anhydride derivative such as alkyl-substituted acid anhydride, esterified acid anhydride, amidated acid anhydride, or maleimide. The reaction between the cyclized rubber and a maleic anhydride or a derivative thereof can be conducted simultaneously to the reaction between a normal rubber and maleic anhydride (see for example US Patent No. 2,622,874 and Japanese Patent Application Publication Laid-Open No. SHO 47(1972)-26167).

It is particularly preferable to carry out the reaction in a solution status at temperature of 40 to 100 $^{\circ}$ C under a presence of a radical generating catalyst with a an aromatic hydrocarbon such as benzene, toluene and xylene as a solvent, or with a mixture of an aromatic hydrocarbon and a saturated aliphatic acid hydrocarbon such as n- hexane and n- heptanes as a solvent. As a radical generating catalyst, a vinyl compound generally used for radical polymerization can be used.

Further, the epoxidized cyclized rubber used in the present invention can be obtained by reacting through a conventional means a cyclized rubber in an inert solvent such as benzene, toluene, chloroform and n- hexane, with an organic peroxides such as acetyl hydroperoxide and perbenzoic acid; an organic hydroperoxides such as t- butylhydroperoxide, cumene hydroperoxide; and a hydroperoxide such as hydrogen peroxide. A cyclized rubber having an epoxy group in its side chain can also be obtained by reacting an unsaturated compound having an epoxy group such as butadiene monoxide, allyl glycidyl ether and glycidyl acrylate under a presence of a radical generating catalyst.

In the present invention, the amount of the acid anhydride or a derivative thereof added in the above-mentioned modified cyclized rubber is suitably 5×10^{-4} to 4×10^{-8} mol per 100 g of the cyclized rubber, and the amount of an epoxy group

(",")

is suitably 5×10^{-4} to 8×10^{-8} mol per 100 g of the

cyclized rubber. The modified cyclized rubber can be used alone or in combination with an unmodified cyclized rubber.